

2SB896, 2SB896A

シリコン PNP プレーナ形 / Si PNP Planar

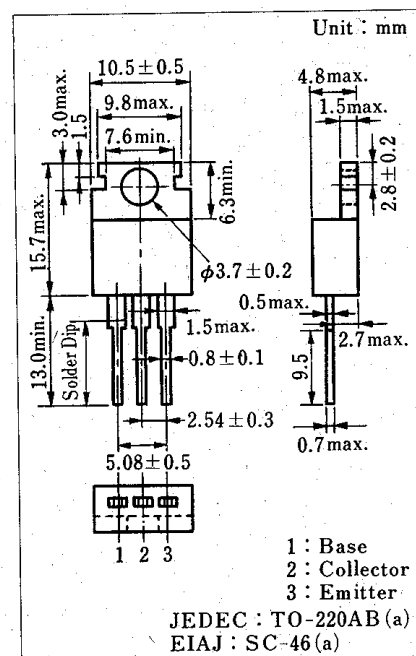
低電圧スイッチング用 / Low Voltage Switching

■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-40	V
		-50	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-20	V
		-40	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-15	A
コレクタ電流	I_C	-10	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	35	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -40\text{ V}, I_E = 0$			-50	μA
		$V_{CB} = -50\text{ V}, I_E = 0$			-50	
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5\text{ V}, I_C = 0$			-50	μA
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = -10\text{ mA}, I_B = 0$	-20			V
			-40			
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -2\text{ V}, I_C = -0.1\text{ A}$	45			
	h_{FE2}^*	$V_{CE} = -2\text{ V}, I_C = -2\text{ A}$	60		260	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -7\text{ A}, I_B = -0.23\text{ A}$			-0.6	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -7\text{ A}, I_B = -0.23\text{ A}$			-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10\text{ V}, I_C = -0.5\text{ A}$		150		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$		200		pF
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = -2\text{ A}, I_{B1} = -66\text{ mA}, I_{B2} = 66\text{ mA}$		0.1		μs
蓄積時間	t_{stg}			0.5		μs
下降時間	t_f			0.1		μs

* h_{FE2} ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE2}	60 ~ 120	90 ~ 180	130 ~ 260